



2SC4097 (3DG4097)

硅 NPN 半导体三极管/SILICON NPN TRANSISTOR

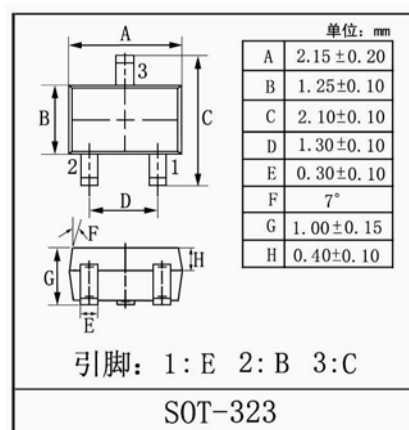
用途:用于中功率放大。

Purpose: Medium power transistor.

特点:共基极输出电容小,与 2SA1577(3CG1577)互补。

Features: Low C_{ob} , complements the 2SA1577(3CG1577).极限参数/Absolute maximum ratings($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	数值 Rating	单位 Unit
V_{CB0}	40	V
V_{CE0}	32	V
V_{EB0}	5.0	V
I_C	500	mA
P_C	200	mW
T_j	150	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

电性能参数/Electrical characteristics($T_a=25^{\circ}\text{C}$)

参数符号 Symbol	测试条件 Test condition		数值 Rating			单位 Unit
			最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max	
V_{CB0}	$I_C=100\mu\text{A}$	$I_E=0$	40			V
V_{CE0}	$I_C=1.0\text{mA}$	$I_E=0$	32			V
V_{EB0}	$I_E=100\mu\text{A}$	$I_C=0$	5.0			V
I_{CB0}	$V_{CB}=-20\text{V}$	$I_E=0$			1.0	μA
I_{EB0}	$V_{EB}=4.0\text{V}$	$I_C=0$			1.0	μA
h_{FE}	$V_{CE}=3.0\text{V}$	$I_C=10\text{mA}$	82		390	
$V_{CE(sat)}$	$I_C=100\text{mA}$	$I_B=10\text{mA}$			0.4	V
f_T	$V_{CE}=5.0\text{V}$	$I_C=20\text{mA}$		250		MHz
C_{ob}	$V_{CB}=10\text{V}$	$I_E=0$		6.0		pF

 h_{FE} 分档、印章/ h_{FE} Classifications、Marking:

h_{FE} 分档 h_{FE} Classifications	P	Q	R
h_{FE} 范围 h_{FE} Range	82~180	120~270	180~390
印章 Marking	HCP	HCQ	HCR

2SC4097 (3DG4097)

